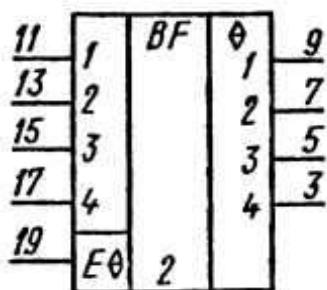
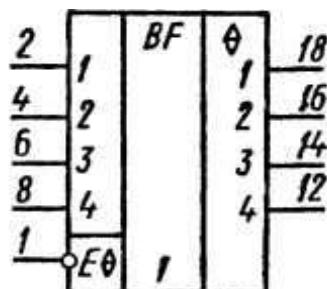


КР1533АП4, КФ1533АП4, ЭКР1533АП4, ЭКФ1533АП4

Микросхемы представляют собой два четырехканальных формирователя четырехразрядных магистральных передатчика) с тремя состояниями на выходе, с прямым и инверсным управлением. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г, 2140.20-В, 4321.20-В.

Назначение выводов: 1, 19 - входы разрешения снятия состояния высокого импеданса ЕΦ; 2 - вход информационный первого элемента 1; 3 - выход информационный второго элемента 4; 4 - вход информационный первого элемента 2; 5 - выход информационный второго элемента 3; 6 - вход информационный первого элемента 3; 7 - выход информационный второго элемента 2; 8 - вход информационный первого элемента 4; 9 - выход информационный второго элемента 1; 10 - общий; 11 - вход информационный второго элемента 1; 12 - выход информационный первого элемента 4; 13 - вход информационный второго элемента 2; 14 - выход информационный первого элемента 3; 15 - вход информационный второго элемента 3; 16 - выход информационный первого элемента 2; 17 - вход информационный второго элемента 4; 18 - выход информационный первого элемента 1; 20 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533АП4, КФ1533АП4,
ЭКР1533АП4, ЭКФ1533АГМ

Таблица истинности

\bar{E}^\diamond	Входы	Выходы	E^\diamond	Входы	Выходы
0	0	0	0	X	\diamond
0	1	1	1	0	0
1	X	\diamond	1	T	1

Примечание. \diamond - состояние высокого импеданса.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 12 \text{ мА}$ $\leq 0,4 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^0 = 24 \text{ мА}$ $\leq 0,5 \text{ В}$

Выходное напряжение высокого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^1 = -0,4 \text{ мА}$ $\geq 2,5 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^1 = -3 \text{ мА}$ $\geq 2,4 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^1 = -15 \text{ мА}$ $\geq 2 \text{ В}$

Прямое падение напряжения на антизвонном диоде $\leq |-1,5| \text{ В}$

Ток потребления при низком уровне выходного

напряжения при $U_n = 5,5 \text{ В}$ $\leq 26 \text{ мА}$

Ток потребления при высоком уровне выходного

напряжения при $U_n = 5,5 \text{ В}$ $\leq 15 \text{ мА}$

Ток потребления в состоянии «выключено»

при $U_n = 6,5 \text{ В}$ $\leq 30 \text{ мА}$

Входной пробивной ток $\leq 0,1 \text{ мА}$

Входной ток низкого уровня $\leq |-0,1| \text{ мА}$

Входной ток высокого уровня $\leq 20 \text{ мкА}$

Выходной ток $|-30| \dots |-112| \text{ мА}$

Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено» $\leq |-20| \text{ мкА}$

Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено» $\leq 20 \text{ мкА}$

Время задержки распространения сигнала при

включении при $U_n = 5 \text{ В}$; $C_H = 50 \text{ пФ}$; $R_H = 0,5 \text{kОм}$ $\leq 10 \text{ нс}$

Время задержки распространения сигнала

при выключении $\leq 11 \text{ нс}$

Время задержки распространения при переходе из

состояния «выключено» в состояние низкого

(высокого) уровня $\leq 21 \text{ нс}$

Время задержки распространения при переходе из

состояния низкого уровня в состояние «выключено» $\leq 25 \text{ нс}$

Время задержки распространения при переходе из

состояния высокого уровня в состояние «выключено»≤ 40 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при

температура не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.